

starpower

您值得信赖的功率模块供应商

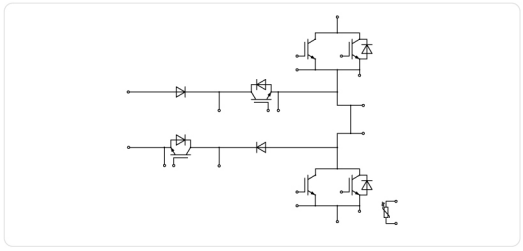
2025 光伏/储能行业
功率器件解决方案

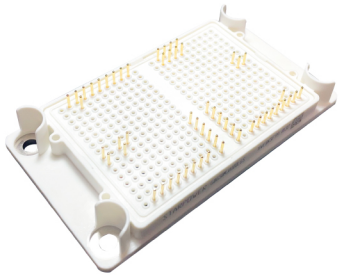
斯达半导体股份有限公司

StarPower Semiconductor Ltd.



光伏 1100V 150kW 解决方案



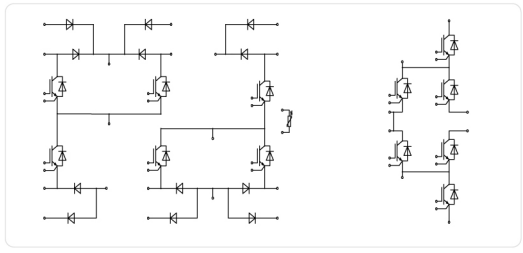


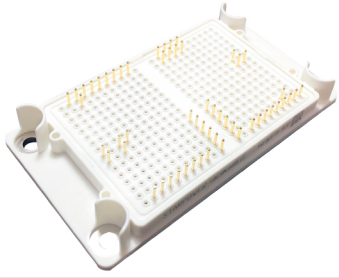
特性

- 基于光伏应用进行优化
- T-NPC 拓扑方案，支持 1100V 母线，功率高达 150kW
- 采用高效微沟槽 IGBT 芯片技术
- 低寄生电感模块设计

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD600TLA120L6L	1200V	600A	Trench-FS Gen7	T-NPC	L6

光伏 1500V 225kW 解决方案





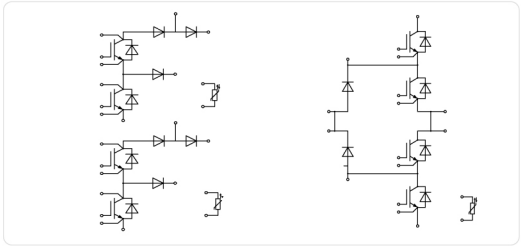
特性

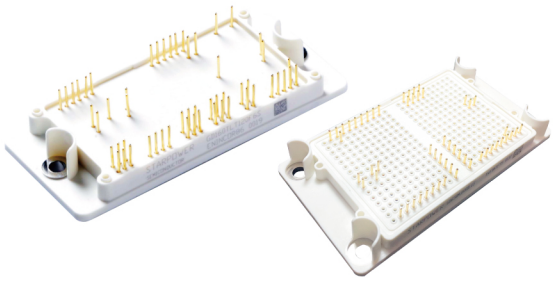
- 基于光伏应用进行优化
- Boost 及 ANPC 拓扑方案，支持 1500V 母线，功率高达 225kW
- 采用高效沟槽 IGBT 芯片技术
- 高效 SiC 二极管匹配 Boost 模块

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD200TSS100L6S	1000V	200A	Trench-FS Gen5	Boost	L6
GD400TAS100L6S	1000V	400A	Trench-FS Gen5	ANPC	L6



光伏 1500V 320kW 解决方案



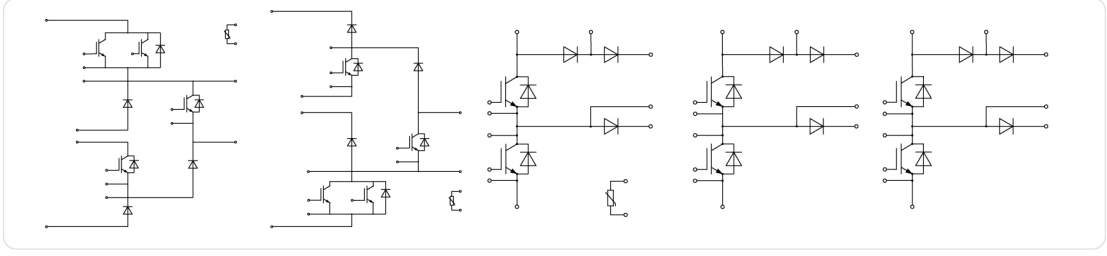


特性

- 基于光伏应用进行优化
- Boost 及 I-NPC 拓扑方案，支持 1500V 母线，功率高达 320kW
- 采用微沟槽 IGBT 芯片技术
- 高效 SiC 二极管匹配 Boost 模块

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD200DFS100F6S	1000V	200A	Trench-FS Gen5	Boost	F6
GD200DFS100L6S	1000V	200A	Trench-FS Gen5	Boost	L6
GD600MJA105L6Q	1050V	600A	Trench-FS Gen7	I-NPC	L6
GD650MJA105L6Q	1050V	650A	Trench-FS Gen7	I-NPC	L6

光伏 1500V 320kW+ 解决方案



特性

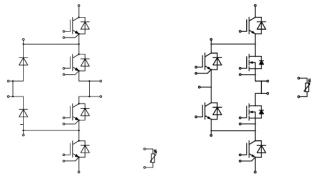
- 基于光伏应用进行优化
- 采用高效微沟槽 IGBT 芯片技术
- 高效 SiC 二极管匹配 Boost 模块
- BOOST 及分离式 ANPC 拓扑方案，支持 1500V 母线，功率高达 320kW+

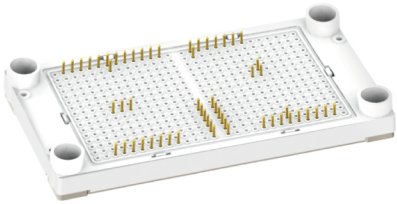
型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD200TFS100F6S	1000V	200A	Trench-FS Gen5	Boost	F6
GD800AXS100F6S	1000V	800A	Trench-FS Gen5	ANPC	F6
GD800AYS100F6S	1000V	800A	Trench-FS Gen5	ANPC	F6



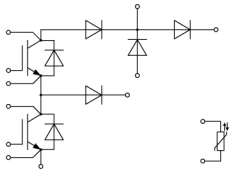
定制服务 400kW-500kW

逆变电路图

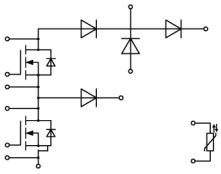




升压电路图



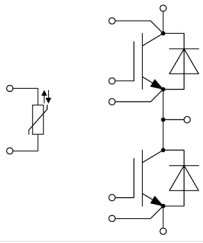
SiC MOS 升压电路



特性

- 可提供多种 Boost 及逆变拓扑方案
- 斯达高性能 SiC MOS
- 高可靠性抗应力镀金端子
- 斯达第八代微沟槽 IGBT 芯片
- Tvj op=175°C 封装可靠性

光伏 / 储能 1500V 集中式解决方案 1





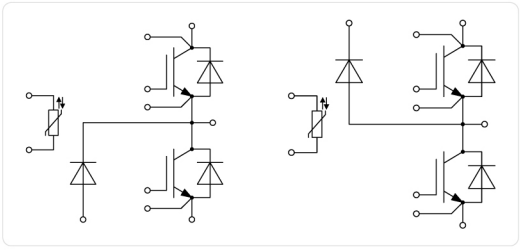
特性

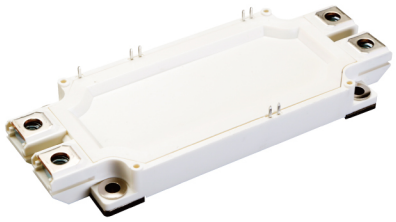
- 基于光伏储能应用优化
- 支持 1500V 母线，可支持 ANPC/INPC 方案
- 高效沟槽型和微沟槽型芯片技术
- 低寄生电感模块封装

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD600HFX120C6SB	1200V	600A	Trench-FS Gen5	Half-Bridge	C6.1
GD750HFA120C6S	1200V	750A	Trench-FS Gen7	Half-Bridge	C6.1
GD800HFA120C6SD	1200V	800A	Trench-FS Gen7	Half-Bridge	C6.1
GD900HFA120C6S	1200V	900A	Trench-FS Gen7	Half-Bridge	C6.1



光伏 / 储能 1500V 集中式解决方案 2



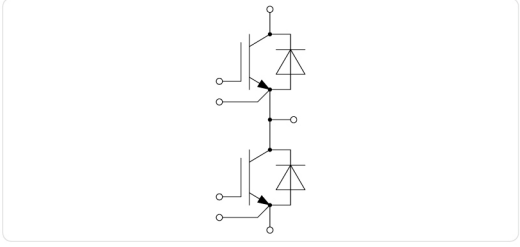


特性

- 基于光伏储能应用优化
- 支持 1500V 母线，可支 INPC 方案
- 高效沟槽型和微沟槽型芯片技术
- 低寄生电感模块封装

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD300MPX/MNX120C6SA	1200V	300A	Trench-FS Gen5	3-level	C6.1
GD450MPX/MNX120C6SA	1200V	450A	Trench-FS Gen5	3-level	C6.1
GD900MPA/MNA120C6SN	1200V	900A	Trench-FS Gen7	3-level	C6.1

光伏 / 储能 1500V 集中式解决方案 3





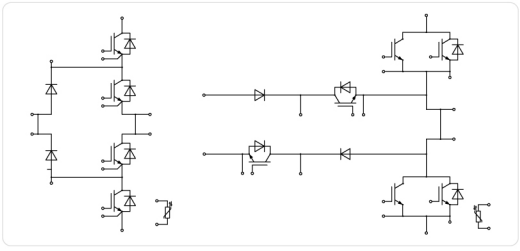
特性

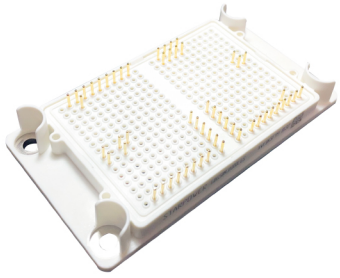
- 基于光伏储能应用优化
- 支持 1500V 母线，可支持 ANPC/INPC 方案
- 高效沟槽型和微沟槽型芯片技术
- 低寄生电感模块封装

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD600HFX120C2SA_B20	1200V	600A	Trench-FS Gen5	Half-Bridge	C2
GD800HFA120C2S_B20	1200V	800A	Trench-FS Gen7	Half-Bridge	C2
GD800HFA120C2S_B12	1200V	800A	Trench-FS Gen7	Half-Bridge	C2



储能 1100V 125kW-150kW 解决方案



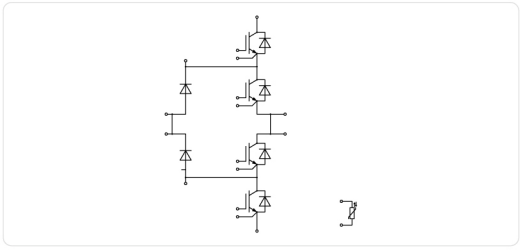


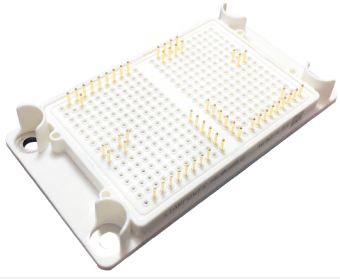
特性

- 基于储能应用进行优化
- 采用高效微沟槽 IGBT 芯片技术
- 低寄生电感模块设计
- I-NPC 拓扑方案，支持 1100V 母线，功率高达 125kW
- T-NPC 拓扑方案，支持 1100V 母线，功率高达 125kW-150kW

型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD450MMA75L6S	750V	450A	Trench-FS Gen7	I-NPC	L6
GD600TLA120L6Q	1200V	600A	Trench-FS Gen7	T-NPC	L6

储能 1500V 215kW / 400kW+ 解决方案

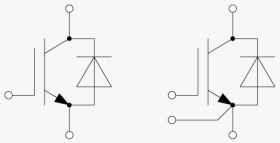


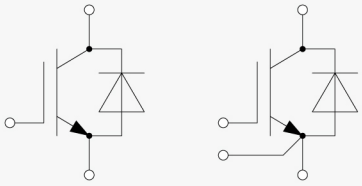


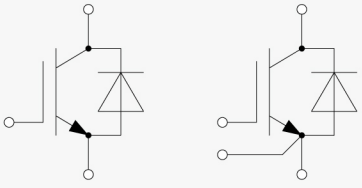
特性

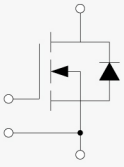
- 基于储能应用进行优化
- 采用高效沟槽 IGBT 芯片技术
- I-NPC 拓扑方案，支持 1500V 母线，功率高达 215kW
- 低寄生电感模块设计

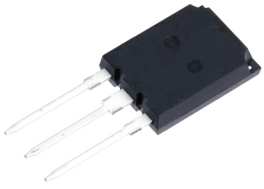
型号	电压	电流	芯片技术	电路结构	封装
GD500MMA120L6S	1200V	500A	Trench-FS Gen7	I-NPC	L6
GD600MHA110L6Q	1100V	600A	Trench-FS Gen7	I-NPC	L6

户用光伏单相机最大 10kW	电压电流等级	封装	电路图
DG30A08T*FS	750V/30A	TO-247-3L TO-247PLUS-3L TO-247P-LUS4L	
DG40A08T*FS	750V/40A		
DG50A08T*FS	750V/50A		
DG75A08T*FS	750V/75A		

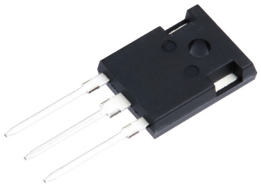
户用光伏三相机最大 50kW	电压电流等级	封装	电路图
DG25A12T*FS	1200V/25A	TO-247-3L TO-247PLUS-3L TO-247PLUS-4L	
DG40A12T*FS	1200V/40A		
DG50A12T*FS	1200V/50A		
DG75A12T*FS	1200V/75A		
DG30A08T*LS	750V/30A		
DG40A08T*LS	750V/40A		
DG50A08T*LS	750V/50A		
DG75A08T*LS	750V/75A		

工商业光伏三相机最大 150kW	电压电流等级	封装	电路图
DG100A12T*FS	1200V/100A	TO-247PLUS-3L TO-247PLUS-4L	
DG120A12T*FS	1200V/120A		
DG140A12T*FS	1200V/140A		
DG100A08T*LS	750V/100A		
DG120A08T*LS	750V/120A		
DG160A08T*LS	750V/160A		

高效率 SiC解决方案	电压电流等级	封装	电路图
DM170S12TDRB	1200V/17mΩ	TO-247PLUS-4L	
DM400S12TDRB	1200V/40mΩ		
DM800S12TDRB	1200V/80mΩ		
DM120L12TDRB	1200V/12mΩ		
DM250S12TDRB	1200V/25mΩ		



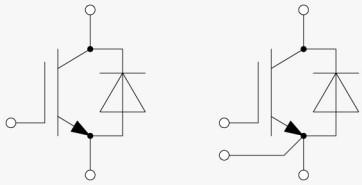
TO-247PLUS-3L

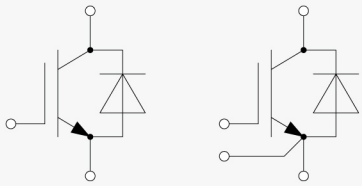


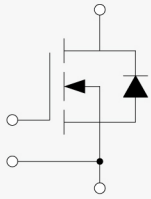
TO-247-3L



TO-247PLUS-4L

户用储能最大 6kW	电压电流等级	封装	电路图
DG25A12T*FS	1200V/25A	TO-247-3L TO-247PLUS-3L TO-247PLUS-4L	
DG40A12T*FS	1200V/40A		
DG50A12T*FS	1200V/50A		
DG75A12T*FS	1200V/75A		
DG30A08T*FS	750V/30A		
DG40A08T*FS	750V/40A		
DG50A08T*FS	750V/50A		
DG75A08T*FS	750V/75A		

工商业储能最大 125kW	电压电流等级	封装	电路图
DG100A12T*FS	1200V/100A	TO-247PLUS-3L TO-247PLUS-4L	
DG120A12T*FS	1200V/120A		
DG140A12T*FS	1200V/140A		
DG100A08T*FS	750V/100A		
DG120A08T*FS	750V/120A		
DG160A08T*FS	750V/160A		

高效率 SiC解决方案	电压电流等级	封装	电路图
DM170S12TDRB	1200V/17mΩ	TO-247PLUS-4L	
DM400S12TDRB	1200V/40mΩ		
DM800S12TDRB	1200V/80mΩ		
DM120L12TDRB	1200V/12mΩ		
DM250S12TDRB	1200V/25mΩ		

斯达半导体股份有限公司

电 话：+86 573 82585600
地 址：浙江嘉兴市南湖区科兴路988号
网 址：www.powersemi.com